Vielteilchen-Wellenfunktionen im Quanten-Hall-Effekt

Inaugural-Dissertation
zur
Erlangung der Doktorwürde
der
Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät
der
Rheinischen Friedrich-Wilhelms Universität
zu Bonn

vorgelegt von
Raimund Varnhagen
aus
Aachen

Bonn 1994

Angefertigt mit Genehmigung der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms Universität Bonn

Referent:	Prof. Dr. Werner Nahm
Korreferent:	Prof. Dr. Günther von Gehlen
Tag der Promotion:	20. 12. 1994

Inhaltsverzeichnis

"... kann ich dir, lieber Leser, in den nächsten Kapiteln nicht viel Unterhaltung versprechen. Wenn du dich bei dem ennuyanten Zeug, das darin vorkommen wird, langweilst, so tröste dich mit mir, der all dieses Zeug sogar schreiben mußte. Ich rate dir, überschlag dann und wann eine Seite, dann kömmst du mit dem Buch schneller zu Ende – ach, ich wollt, ich könnt es ebenso machen! "

H. Heine, Die Bäder von Lucca

I Einleitung

Die Entdeckung der Quantisierung der Hall-Leitfähigkeit in ganzzahlige Vielfache von $\frac{e^2}{h}$ durch K. von Klitzing, G. Dorda und M. Pepper [1] ist neben der Entdeckung der Hochtemperatur-Supraleitung der bedeutendste Erfolg der Festkörperphysik der letzten zwanzig Jahre. Der Quanten-Hall-Effekt (QHE) wurde erstmals im Februar 1980 von K.v. Klitzing und seinen Mitarbeitern bei Untersuchungen des Einflusses von Magnetfeldern auf die elektronischen Eigenschaften von MOS (Metall-Oxid-Semiconductors) Feldeffekttransistoren gemessen, fast genau 100 Jahre nach der Beobachtung des klassischen Hall-Effekts durch Edwin Hall [2]. Die ungeheure Präzission der Quantisierung war sehr überraschend, da es vorher keine theoretischen Anzeichen dafür gegeben hat.

Ebenso erstaunlich war 1982 die Entdeckung durch D. Tsui, H. Strömer und D. Gossard, daß die Hall-Leitfähigkeit auch fraktionale Vielfache von $\frac{e^2}{h}$ annehmen kann. Seitdem unterscheidet man zwischen Integer Quanten-Hall-Effekt (IQHE) und Fraktionalem Quanten-Hall-Effekt (FQHE), insbesondere da bei der theoretischen Beschreibung des FQHE Elektron-Elektron-Wechselwirkungen berücksichtigt werden müssen, die man jedoch beim IQHE vernachlässigen kann. In Laufe der Zeit wurde klar, daß aber nicht beliebige fraktionale Vielfache von $\frac{e^2}{h}$ beim FQHE meßbar sind, sondern daß ausgezeichnete dominieren.

Seit diesen Entdeckungen hat der QHE sowohl Experimentalphysiker, als auch theoretische Physiker gleichermaßen interessiert, wie sich an der Flut von Publikationen in den letzten vierzehn Jahren zeigt. Einerseits liefert der Quanten-Hall-Effekt heute die genaueste Bestimmung der Sommerfeldschen Feinstrukturkonstanten $\alpha = \frac{e^2}{\hbar c}$, der wichtigsten Konstanten der Quantenelektrodynamik, und hat zur Neudefinition des elektrischen Widerstandes geführt. Andererseits ist man weit von einem Verständnis des Quanten-Hall-Effektes entfernt. Es gibt keine vollständige Theorie des QHE, wie zum Beispiel die BCS-Theorie der Supraleitung. Nichtdestotrotz hat der QHE viele neue und wertvolle Erkenntnisse für die theoretische Physik geliefert.

Einen sehr wichtigen Beitrag zum Verständnis topologischer Quantisierung beim IQHE lieferten D.J. Thouless et.al. [12] wie auch J.E. Avron und R. Seiler [14], die die Hall-Leitfähigkeit von der Kubo-Formel ableiteten und zeigten, daß sie als die erste Chernzahl eines Geradenbündels interpretiert werden kann, die automatisch eine ganzzahlige topologische Konstante ist (Abschnitt 2.3).

Eine andere bedeutende Erkenntnis zum Verständnis des QHE, war die Entdeckung von R. Laughlin, daß der Grundzustand eines Quanten-Hall-Systems, insbesondere beim FQHE, sich grundlegend von bisher bekannten Zuständen kondensierter Materie unterscheidet [18]. Er war in der Lage, durch Vergleich mit numerischen Rechnungen explizit ihre Wellenfunktionen, die sich erstmals nicht als Slaterdeterminante ausdrücken ließen, anzugeben. Diese Zustände beschreiben inkompressibele Quantenflüssigkeiten (Abschnitt 3.1).

In dieser Arbeit wird zunächst gezeigt, daß diese Inkompressibilitätseigenschaft des Grundzustandes nicht nur wie schon bekannt im IQHE, sondern auch im Falle des FQHE durch explizite Berücksichtigung der Elektron-Elektron-Wechselwirkungen eine unendlich-dimensionale Symmetrie bewirkt, deren explizite algebraische Formulierung es ermöglicht, das Randanregungsspektrum des QHE zu beschreiben und es mit bestimmten konformen Quantenfeldtheorien zu identifizieren (Abschnitt 3.3 - 3.6). Danach wird gezeigt, wie die oben erwähnten bislang unabhängigen Beschreibungen von Teilaspekten des QHE – topologische Quantisierung und Laughlin-Wellenfunktionen – zusammenhängen, indem ausgehend von Laughlin-Wellenfunktionen mit periodischen Randbedingungen Vektorbündel konstruiert werden, die die Entartung des Grundzustandes beschreiben (Abschnitt 4.1). Es stellt sich heraus, daß die erste Chernzahl dividiert durch den Rang des Vektorbündels die richtige Hall-Leitfähigkeit ergibt. Beschränkt man sich nur auf stabile Vektorbündel, so erhält man, zusammen mit einigen physikalisch natürlichen Bedingungen, nur die experimentell dominierenden Brüche; hier wird also ein Auswahlkriterium angegeben. In diesen Fällen kann man auch die Fluktuationen der Krümmung dieser Vektorbündel berechnen und zeigen, daß sie im Limes unendlich vieler Teilchen gegen Null konvergieren. Einerseits bedeutet dies physikalisch die Unabhängigkeit der Hall-Leitfähigkeit von den Randbedingungen, eine unerläßliche Voraussetzung für die Beobachtbarkeit des QHE, andererseits zeigt es eine neue mathematische Eigenschaft der Laughlin-Wellenfunktionen (Abschnitt 4.2). Der letzte Punkt ist auch für die Mathematik von Interesse, da ein Theorem von Donaldson den Zusammenhang zwischen Stabilität und der Existenz von Metriken mit konstanter Krümmung zeigt, und die Laughlin-Wellenfunktionen genau eine Metrik mit dieser Eigenschaft liefern (Abschnitt 4.3). Dies verdeutlicht das Zusammenspiel von experimenteller Physik, theoretischer Physik und Mathematik.

Dieser Arbeit liegen folgende bereits publizierte Artikel zu Grunde:

M. Flohr, R. Varnhagen, *Infinite Symmetry in the Fractional Quantum Hall Effect*, J. Phys. **A27** Math. Gen. (1994) 3999.

R. Varnhagen, *Topology and Fractional Quantum Hall Effect*, BONN-TH-94-22, hep-th 9411031, eingereicht bei Nucl. Phys. **B**.

I.1 Klassischer Hall-Effekt und Drude-Theorie

Die einfachste Theorie der elektrischen Leitfähigkeit ist halb-klassisch und die Quantenmechanik kommt nur indirekt ins Spiel. Sie basiert auf dem Konzept von mittlerer freier Weglänge l_0 und mittlerer freier Zeit τ_0. In diesem Bild wandert ein Elektron mit Ladung $-e$ und (Fermi-) Geschwindigkeit v_F eine mittlere Distanz $l_0 = v_F\tau_0$, bevor es zu einer neuen Geschwindigkeit gestreut wird, deren Mittelwert null ist. Ist ein schwaches elektrisches Feld E eingeschaltet, so wird das Elektron mit Masse m zwischen zwei Stößen auf die Geschwindigkeit

$$\Delta\vec{v} = \frac{-e\tau_0}{m}\vec{E} \qquad \text{(Driftgeschwindigkeit)} \tag{1.1}$$

beschleunigt. Addiert man nun die Beiträge aller Elektronen auf, erhält man als Stromdichte

$$\vec{j} = -ne\Delta\vec{v}\,, \tag{1.2}$$

wobei n die Elektronendichte bezeichnet. Damit ergibt sich

$$\vec{j} = \sigma_0\vec{E} \tag{1.3}$$

$$\sigma_0 = \frac{ne^2\tau_0}{m}\,. \tag{1.4}$$

Quanteneffekte kommen durch die Bandstruktur, die die Masse der Elektronen m_e zu einer effektiven Masse m ändert, ins Spiel, sowie durch den Wert von τ_0. Außerdem folgt aus dem Pauli-Prinzip, daß nur die Elektronen an der Fermi-Kante zur Leitfähigkeit beitragen. In der Anwesenheit eines magnetischen Feldes wird die Bahn der Elektronen durch die Lorentzkraft F_L gekrümmt.

$$F_L = -e\frac{\vec{v}}{c} \times \vec{B} \tag{1.5}$$

Faßt man alle Kräfte zusammen, so ergibt sich

$$\Delta\vec{v} = -\frac{e}{m}\tau_0(\vec{E} + \frac{\Delta\vec{v}}{c} \times \vec{B}) \tag{1.6}$$

$$\Rightarrow \qquad \vec{j} = \sigma_0\vec{E} - \frac{\sigma_0}{nec}\vec{j} \times \vec{B}\,. \tag{1.7}$$

Von nun spezialisieren wir uns auf zwei Dimensionen, parametrisiert durch (x, y), wobei das Magnetfeld in die z-Richtung zeigt. Von (1.7) kann man leicht den spezifische Widerstands-Tensor ρ ablesen:

$$\rho = \begin{pmatrix} \rho_0 & \frac{B}{nec} \\ -\frac{B}{nec} & \rho_0 \end{pmatrix}, \tag{1.8}$$

mit $\rho_0 = 1/\sigma_0$. Dies zeigt die lineare Abhängigkeit des Hall-Widerstandes vom Magnetfeld B beim klassischen Hall-Effekt. Der Leitfähigkeits-Tensor σ ist das Matrixinverse von ρ, dessen Komponenten wie folgt gegeben sind:

$$\begin{aligned} \sigma_{xx} &= \sigma_{yy} = \frac{\sigma_0}{1 + \omega_c^2 \tau_0^2} \\ \sigma_{xy} &= -\sigma_{yx} = \frac{nec}{B} + \frac{1}{\omega_c \tau_0} \sigma_{xx} \,. \end{aligned} \tag{1.9}$$

Die Zyklotron Frequenz ist $\omega_c = \frac{eB}{mc}$. Dies liefert in vielen Experimenten sehr gut Approximationen der erzielten Messungen, insbesondere kann man so Ladungsträgerkonzentrationen bestimmen oder zwischen Elektron- oder Lochleitung unterscheiden. Da bei den bisherigen Überlegungen Quanteneffekte nur minimal berücksichtigt wurden, muß man die Grenzen der halbklassischen Approximation abschätzen, um die experimentellen Rahmenbedingungen für das Auftreten von Quantenphänomenen zu bestimmen. Diese treten dann auf, wenn 1. die Periode der Zyklotronfrequenz viel kleiner als die mittlere freie Zeit der Elektronen im Kristallgitter ist, d.h.

$$\omega_c \tau_0 \gg 1 \,, \tag{1.10}$$

und 2. nur die niedrigsten quantenmechanischen Energiezustände besetzt sind, d.h.

$$\hbar\omega_c \gg kT \,. \tag{1.11}$$

Setzt man eine typische mittlere freie Zeit von $\tau_0 = 10^{-12}s$ voraus, so muß man bei Temperaturen unterhalb von 4-5 Kelvin und Magnetfeldern stärker als 10 Tesla mit dem Auftreten von Quantenphänomenen rechnen, die nicht mehr durch die halbklassische Approximation beschrieben werden können.

I.2 Experimenteller Aufbau

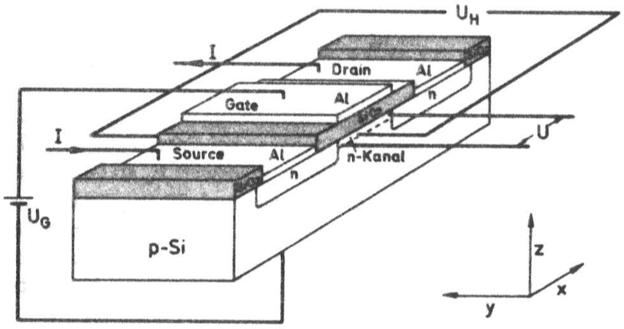

Abbildung 1: Selbstsperrender n-Kanal MOSFET

Abbildung 1 zeigt schematisch den Aufbau eines selbstsperrenden n-Kanal Metal-Oxide-Semiconductor-Field-Effect-Transistors (MOSFET) [7]. Auf eine (100)-Schnittfläche eines p-leitenden Silicium-Einkristalls ist über eine ungefähr 5000Å dicke Isolationsschicht aus SiO_2 eine Metallschicht als sogenannte Gate-Elektrode aufgedampft. Die Stromzuführung erfolgt über zwei als 'Source' und 'Drain' bezeichnete hochdotierte n-leitende Bereiche, die ebenfalls mit metallischen Elektroden versehen sind. Liegt zwischen Gate und Halbleiterkristall keine elektrische Spannung, so ist ein Stromfluß zwischen Source und Drain wegen sich ausbildender Sperrschichten an einem der beiden p-n-Übergängen nicht möglich (deshalb die Bezeichnung selbstsperrend). Durch Anlegen einer positiven Spannung zwischen Gate und Halbleiter wird hingegen unmittelbar an der Grenzfläche zwischen Isolator und Halbleiter (im Abstand von $\sim$ 25 Å) durch Influenz ein n-leitender Kanal zwischen Source und Drain aufgebaut. Seine Leitfähigkeit kann durch die Gate-Spannung U_G gesteuert werden. Das besondere an dieser n-leitenden Randschicht ist nun, daß sie unter geeigneten Bedingungen als eine zwei-dimensionale Ladungsträgerschicht aufgefaßt werden kann. Dies erkennt man an folgender Abbildung.

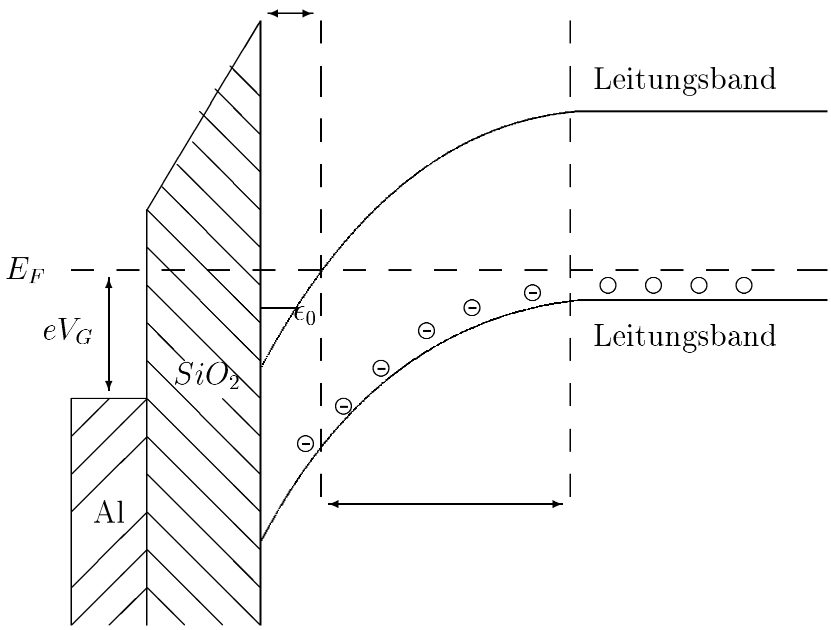

Abbildung 2: Querschnitt durch den MOSFET

Eine positive Spannung zwischen Gate und Halbleiter führt zu einer Absenkung der potentiellen Elektronenenergie in der Randschicht und somit zu der in der Abbildung 2 dargestellten Bandverbiegung. Überschreitet diese Spannung einen bestimmten Schwellenwert, so wird die untere Kante des Leitungsbandes an der Grenzfläche zum Isolator unter das Fermi-Niveau abgesenkt. Die Elektronen können sich allerdings nur parallel zur Grenzfläche bewegen, denn senkrecht zu der Grenzfläche befinden sie sich in einem angenähert dreieckigen Potentialtopf, und ihre Bewegung ist deshalb in dieser Richtung quantisiert. Löst man die Schrödingergleichung für dieses Potential, so sieht man, daß die Energiedifferenz zwischen den beiden untersten Energieniveaus $\epsilon_1 - \epsilon_0$ typischerweise $\sim$ 20 meV (oder $\sim$ 200 K) beträgt (siehe Abbildung 3). Dies ist viel größer als die Temperaturen, bei denen der QHE beobachtet wird, so daß nur der unterste Energiezustand besetzt ist, der eine typische Breite von 30 − 50Å hat.

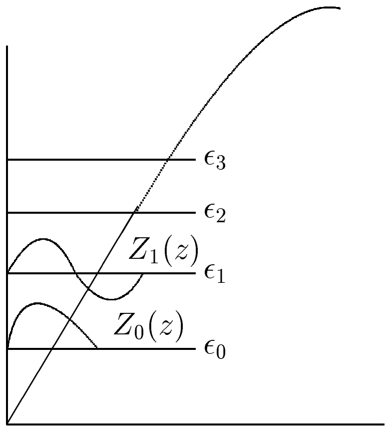

Abbildung 3: Diskrete Energieniveaus senkrecht zur Ladungsträgerschicht

I.3 Experimentelle Resultate

Bei Temperaturen unter 1 Kelvin und bei Magnetfeldern bis zu 20 Tesla fanden K.v. Klitzing und seine Mitarbeiter bei Si/SiO_2 Feldeffekttransistoren, daß die Hall-Leitfähigkeit in Abhängigkeit des magnetischen Feldes B, unabhängig von der experimentellen Anordnung, in Vielfache von $\frac{e^2}{h}$ quantisiert ist, sobald die longitudinale Leitfähigkeit σ_{xx} verschwindet. Dies ist abweichend von dem klassischen Ergebnis, das einen linearen Zusammenhang zwischen Hall-Leitfähigkeit und magnetischem Feld vorhersagt. Abbildung 4 zeigt ein solches Experiment für einen GaAs/$Al_x Ga_{1-x}$As-Halbleiter; man erkennt sehr deutlich das gleichzeitige Auftreten von Hall-Plateaus und dem Verschwinden der longitudinalen Leitfähigkeit.

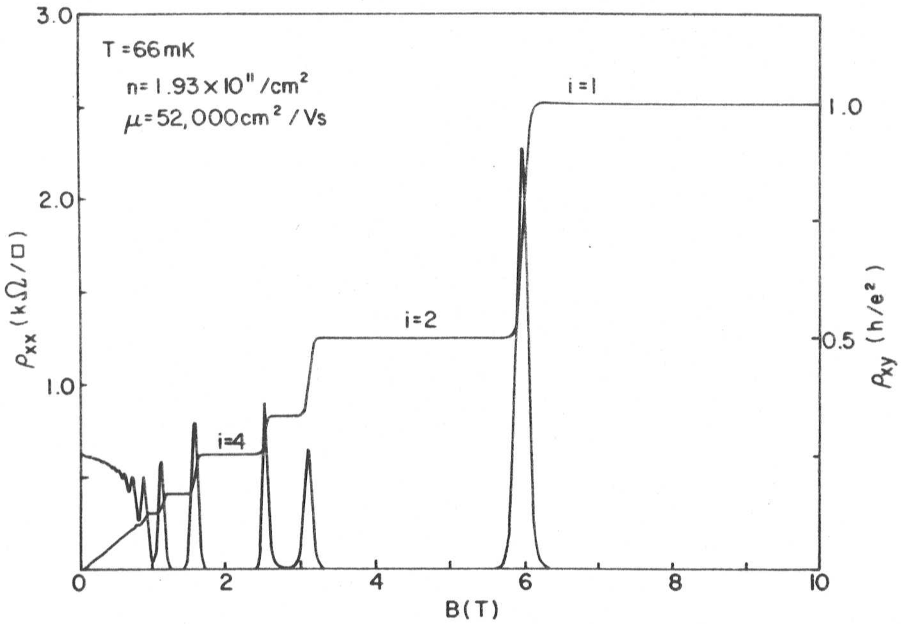

Abbildung 4: ρ_{xx} und ρ_{xy} gegen B

Die ungeheure Präzision (relative Genauigkeit von $\sim 10^{-8}$) dieses Experiments war sehr überraschend, da bisher der elektrische Widerstand oder die elektrische Leitfähigkeit eine materialabhängige Größe waren, die von Temperatur, magnetischem Feld, Frequenz und anderen Größen abhing, vor allem aber von der Größe und Geometrie des Leiters. Der letzte Punkt läßt sich relativ einfach verstehen und ist eine bis dahin nicht berücksichtigte Besonderheit der Zweidimensionalität. Ist b die Breite des Quanten-Hall-Systems, so gilt in diesem quasi zwei-dimensionalen Problem für die Stromdichte: $j = I/b$. Es gilt also:

$$\sigma_H^{\text{spez.}} = \frac{j}{E_H} = \frac{I}{V_H} = \sigma_H \,. \tag{1.12}$$

Somit sind die spezifische Hall-Leitfähigkeit und die Hall-Leitfähigkeit identisch, und die Abmessungen des Systems spielen keine Rolle mehr.

Wie weitere Experimente gezeigt haben, sind Verunreinigungen und Störstellen in den Halbleitern für die Beobachtbarkeit des QHE notwendig. Durch Reduktion der Verunreinigungen und Störstellen und Messung der Hall-Leitfähigkeit bei Temperaturen im Milli-Kelvin-Bereich bei gleichzeitiger Erhöhung